

2025年7月期（2024年8月～2025年7月）決算説明会

決算概要 事業環境および業績予想

サムコ株式会社 東証プライム市場 証券コード：6387

代表取締役社長 兼 COO
川邊 史

2025年9月11日（木）

<https://www.samco.co.jp/ir/>

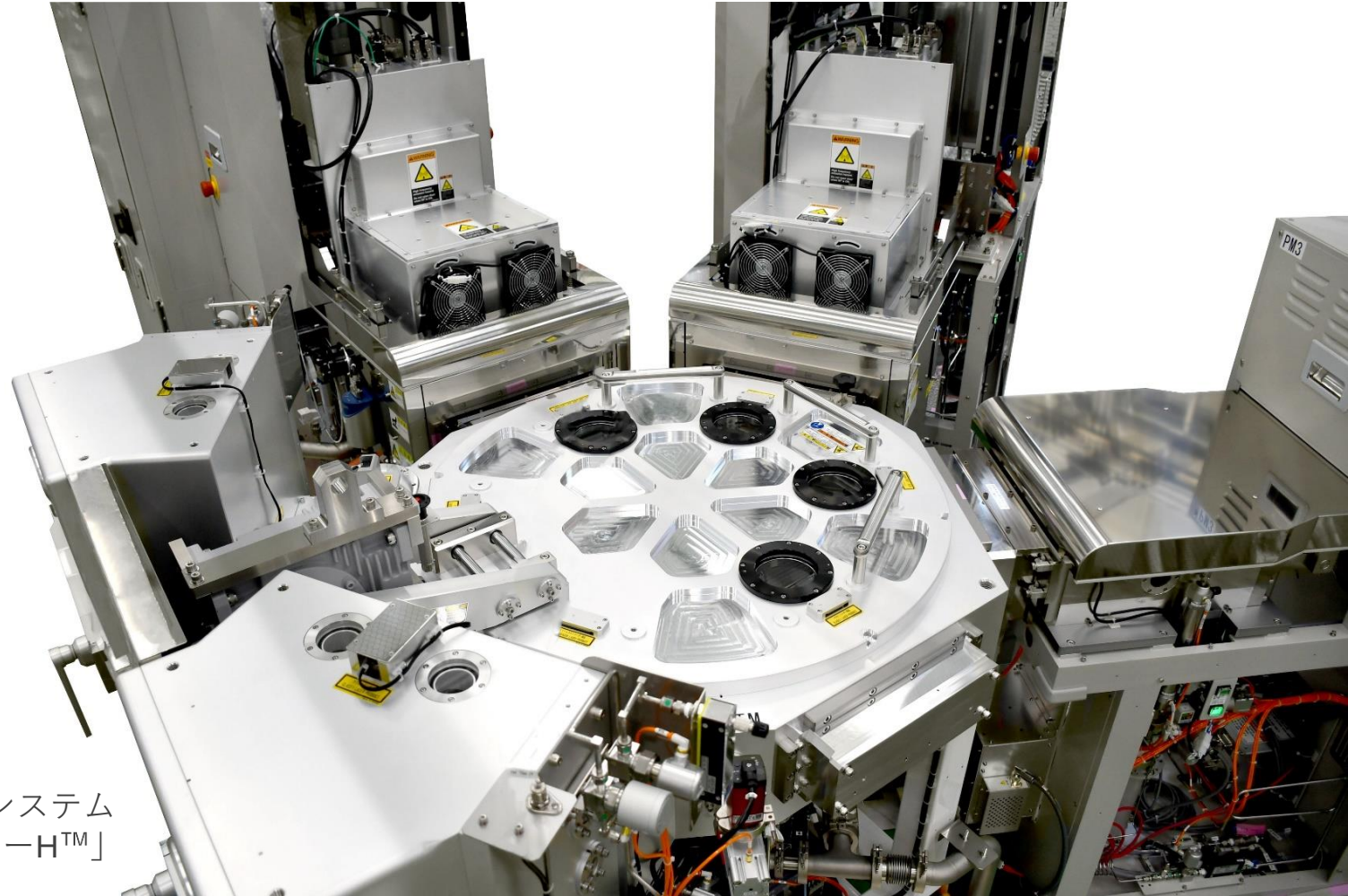
将来の見通しに関する記述について

本資料の将来の見通しに関する記述は、作成時点で入手可能な情報に基づいた当社の予測です。
既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因によって、実際の業績が大きく異なる可能性があります。

目次

1. 2025年7月期 決算概要
2. 2026年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料

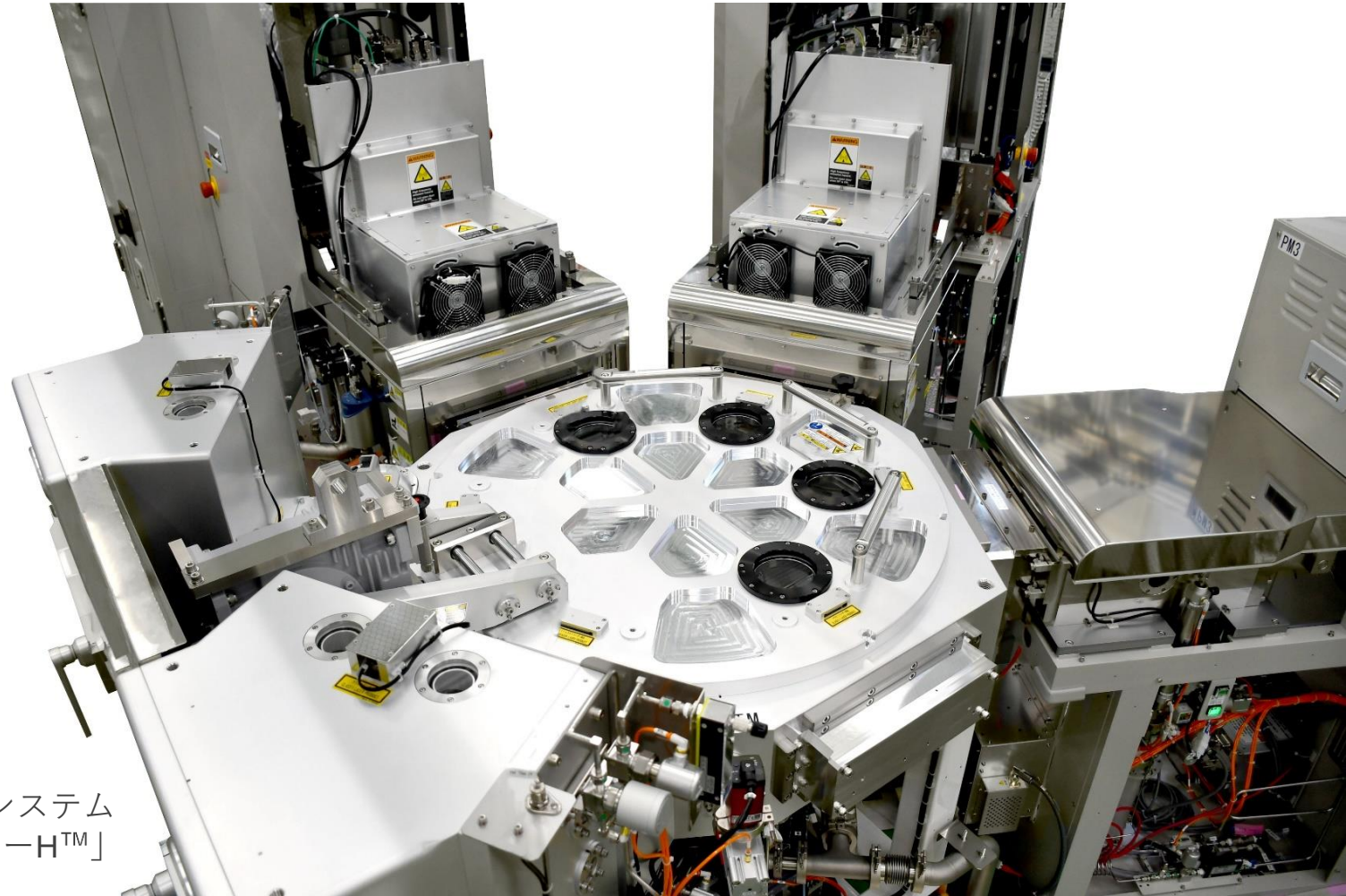
電子デバイス製造向けクラスターツールシステム
「クラスターH™」



目次

1. 2025年7月期 決算概要
2. 2026年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料

電子デバイス製造向けクラスターツールシステム
「クラスターH™」



25/7月期 業績ハイライト

売上高

93.4 億円

前年同期比 +13.9%

4期連続増収・過去最高

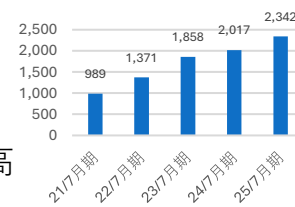


営業利益

23.4 億円

前年同期比 +16.1%

5期連続増益・過去最高

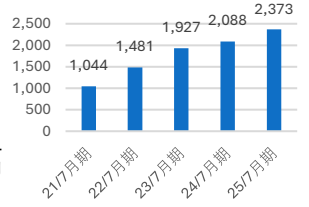


経常利益

23.7 億円

前年同期比 +13.6%

6期連続増益・過去最高



当期純利益

16.9 億円

前年同期比 +15.3%

6期連続増益・過去最高

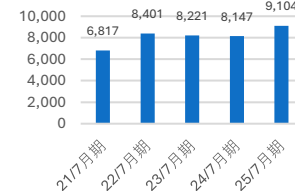


受注高

91.0 億円

前年同期比 +11.8%

過去最高



受注残高

51.2 億円

前年同期比 △4.4%

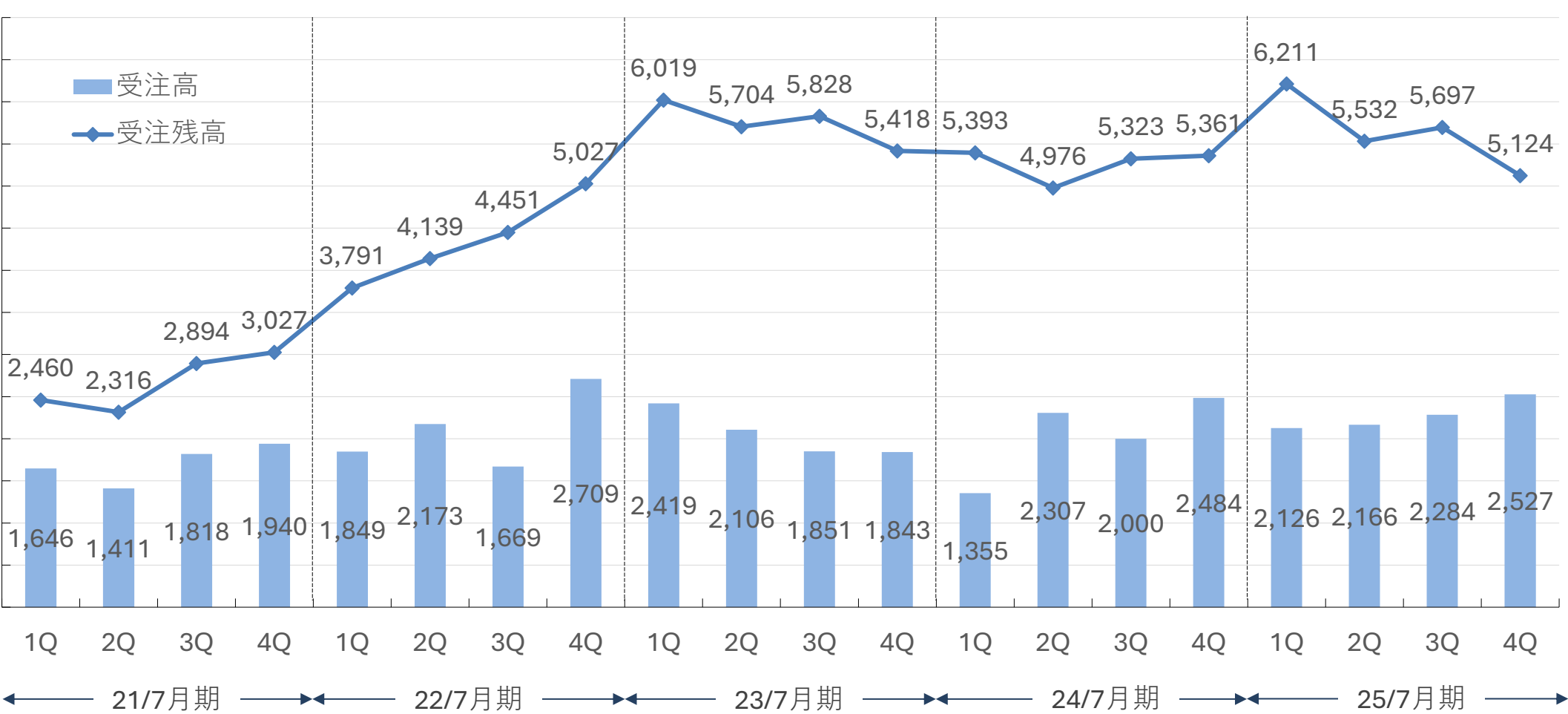


25/7月期 決算概要

				(百万円)	
	24/7月期	25/7月期	前年同期比	2024年9月発表 業績予想	2025年5月発表 業績予想
売上高	8,203	9,342	13.9%	9,500	9,160
売上総利益	4,193	4,668	11.3%	-	-
売上高総利益率	51.1%	50.0%	-	-	-
営業利益	2,017	2,342	16.1%	2,220	2,290
営業利益率	24.6%	25.1%	-	-	-
経常利益	2,088	2,373	13.6%	2,240	2,280
当期純利益	1,471	1,697	15.3%	1,530	1,550
受注高	8,147	9,104	11.7%		
受注残高	5,361	5,124	△4.4%		

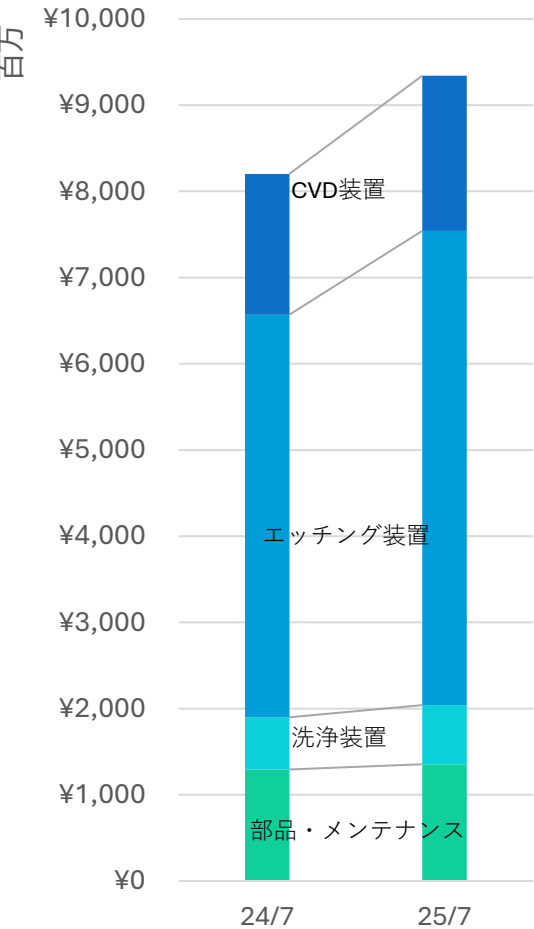
受注高と受注残高推移

(百万円)



25/7月期 装置別売上高

売上高の推移



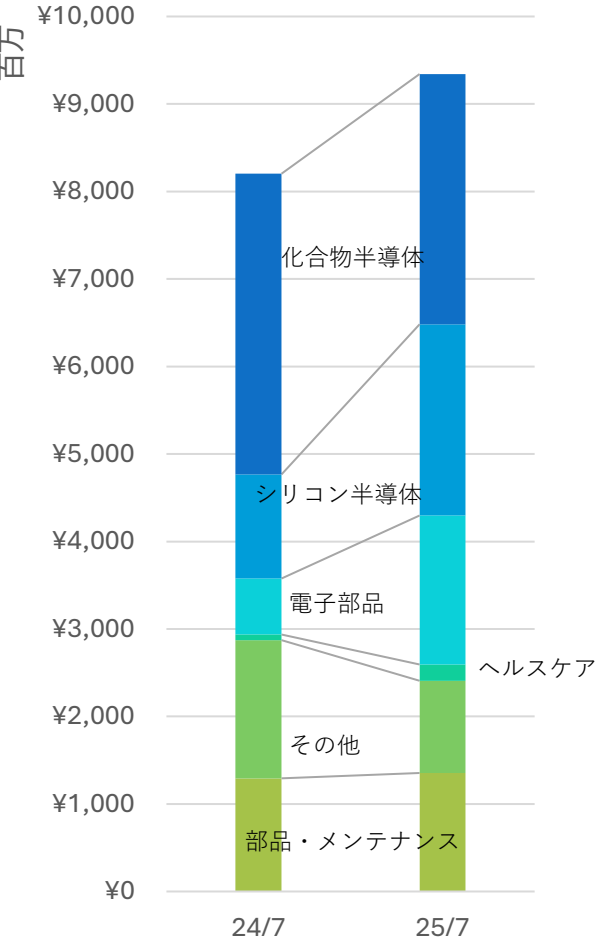
構成比の推移



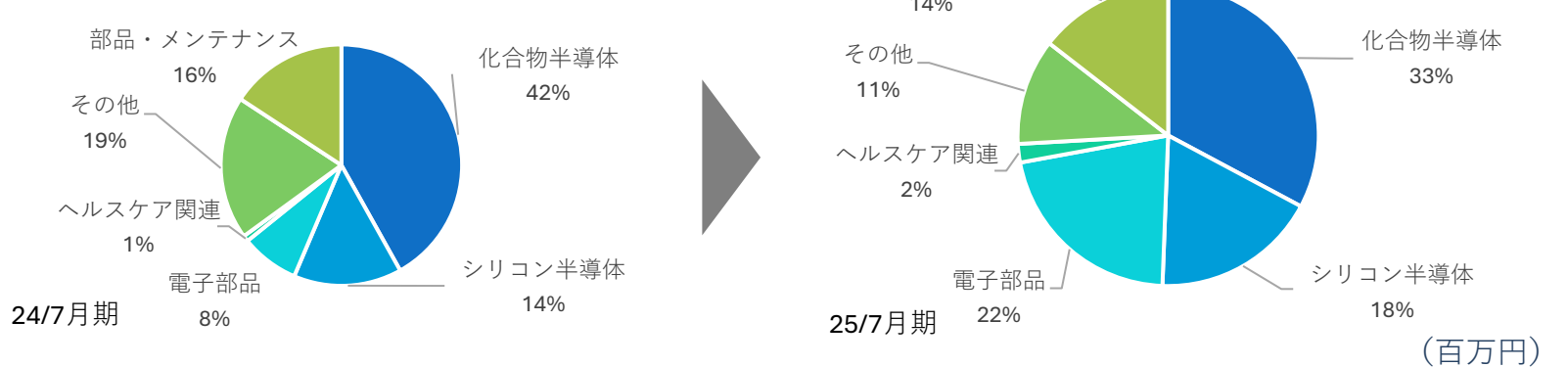
24/7月期			25/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
CVD装置	1,632	19.9%	1,799	19.3%	10.2%
エッチング装置	4,671	56.9%	5,503	58.9%	17.8%
洗浄装置	605	7.4%	685	7.3%	13.2%
部品・メンテナンス	1,293	15.8%	1,354	14.5%	4.7%
合計	8,203	100.0%	9,342	100.0%	13.9%

25/7月期 用途別売上高

売上高の推移



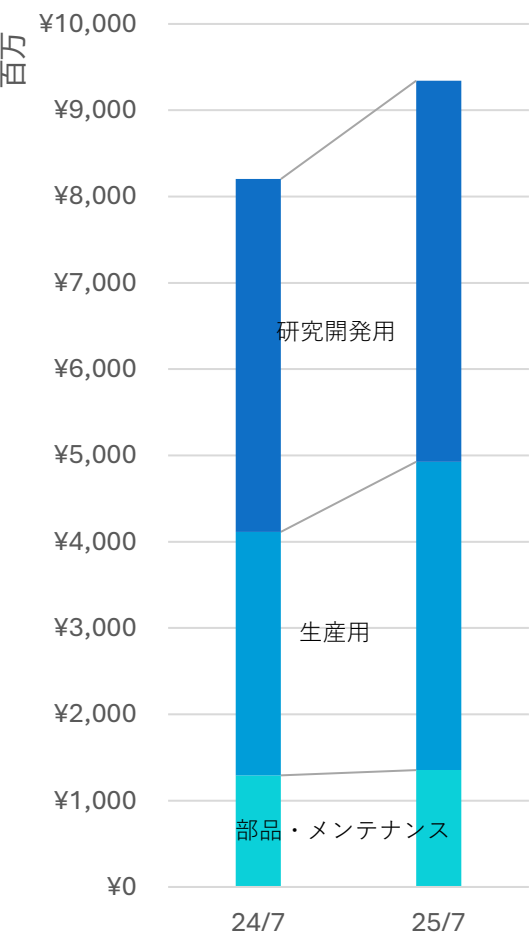
構成比の推移



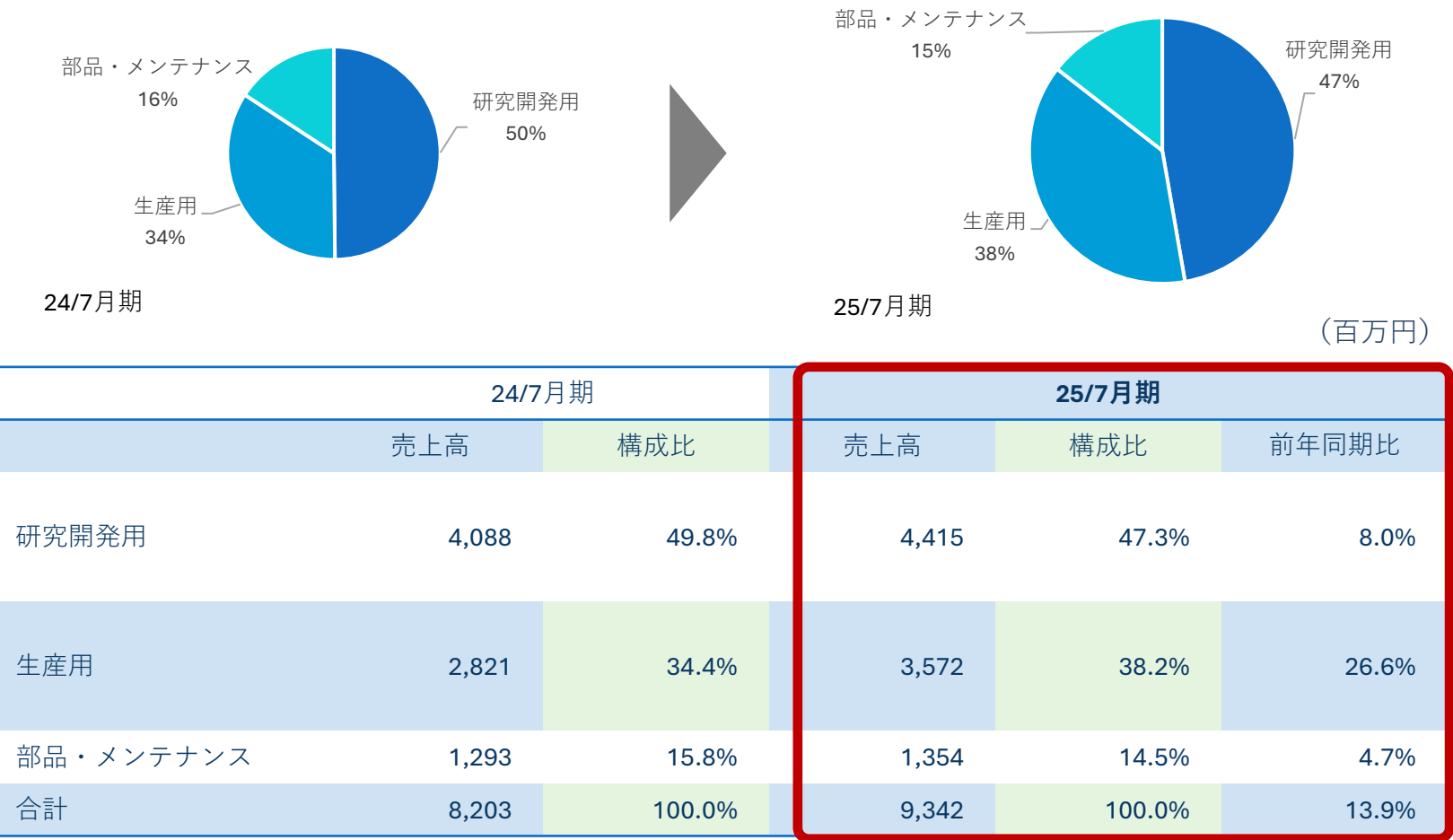
	24/7月期		25/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
化合物半導体分野	3,436	41.9%	3,066	32.8%	△10.8%
シリコン半導体分野	1,189	14.5%	1,665	17.8%	40.0%
電子部品分野	640	7.8%	2,004	21.5%	213.2%
ヘルスケア関連分野	64	0.8%	185	2.0%	189.0%
その他	1,579	19.3%	1,066	11.4%	△32.5%
部品・メンテナンス	1,293	15.8%	1,354	14.5%	4.7%
合計	8,203	100.0%	9,342	100.0%	13.9%

25/7月期 目的別売上高

売上高の推移

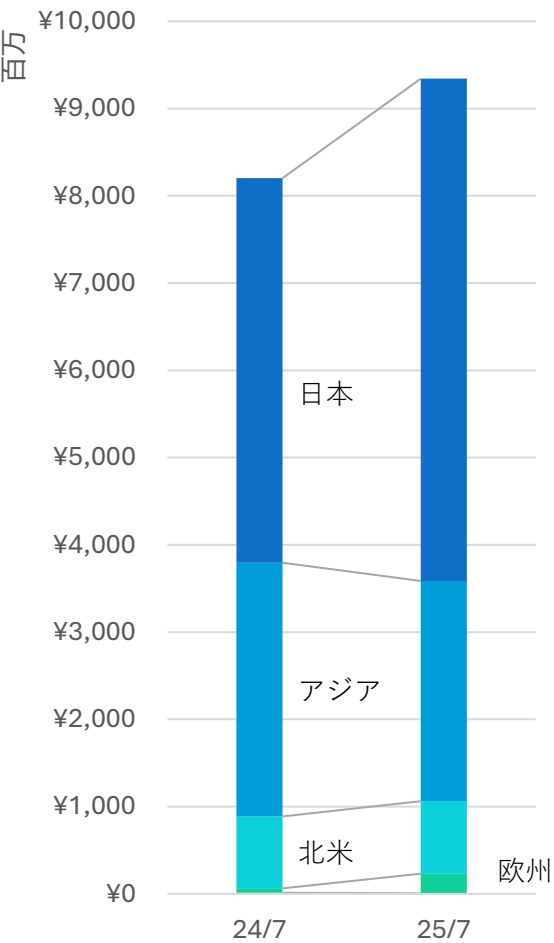


構成比の推移



25/7月期 地域別売上高

売上高の推移

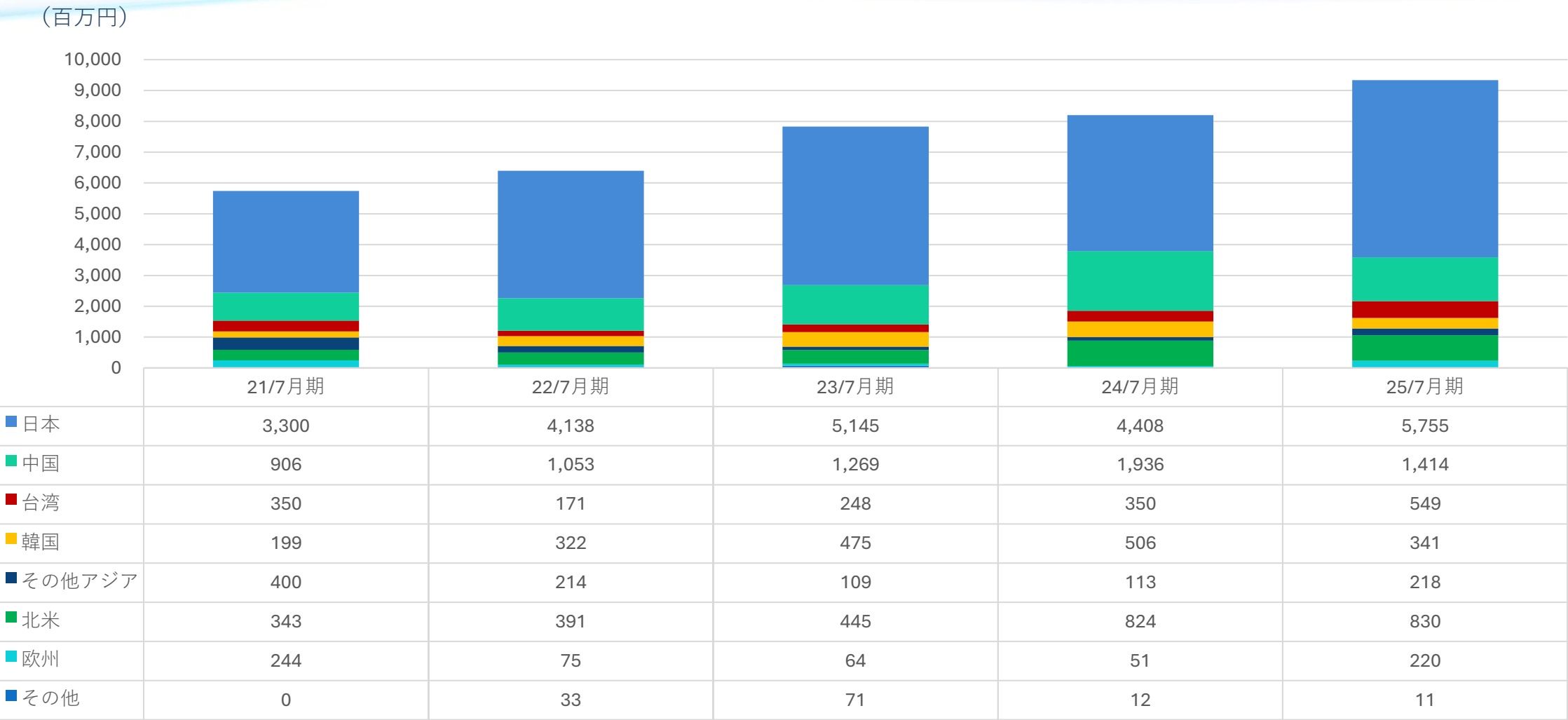


構成比の推移

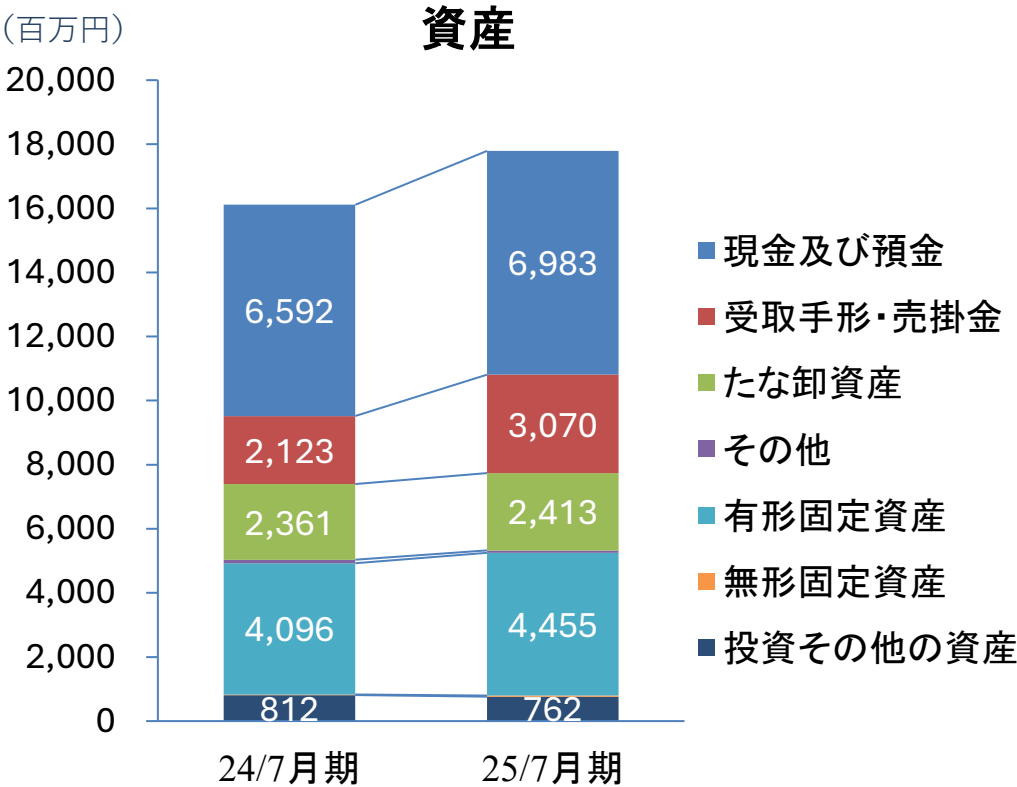


	24/7月期		25/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
日本	4,408	53.7%	5,755	61.6%	30.6%
アジア	2,907	35.4%	2,524	27.0%	△15.2%
北米	824	10.0%	830	8.9%	0.7%
欧州	51	0.6%	220	2.4%	331.1%
その他	12	0.2%	11	0.1%	△11.6%
海外合計	3,794	46.3%	3,586	38.4%	△5.8%
合計	8,203	100.0%	9,342	100.0%	13.9%

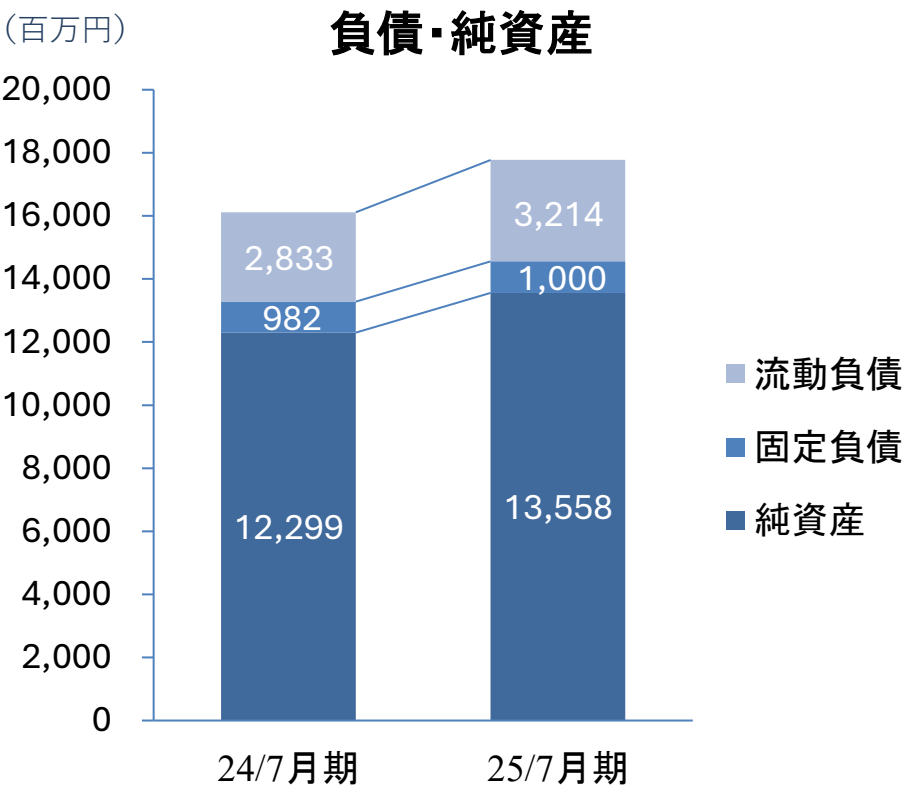
過去5期 地域別売上高



貸借対照表（前事業年度末比）

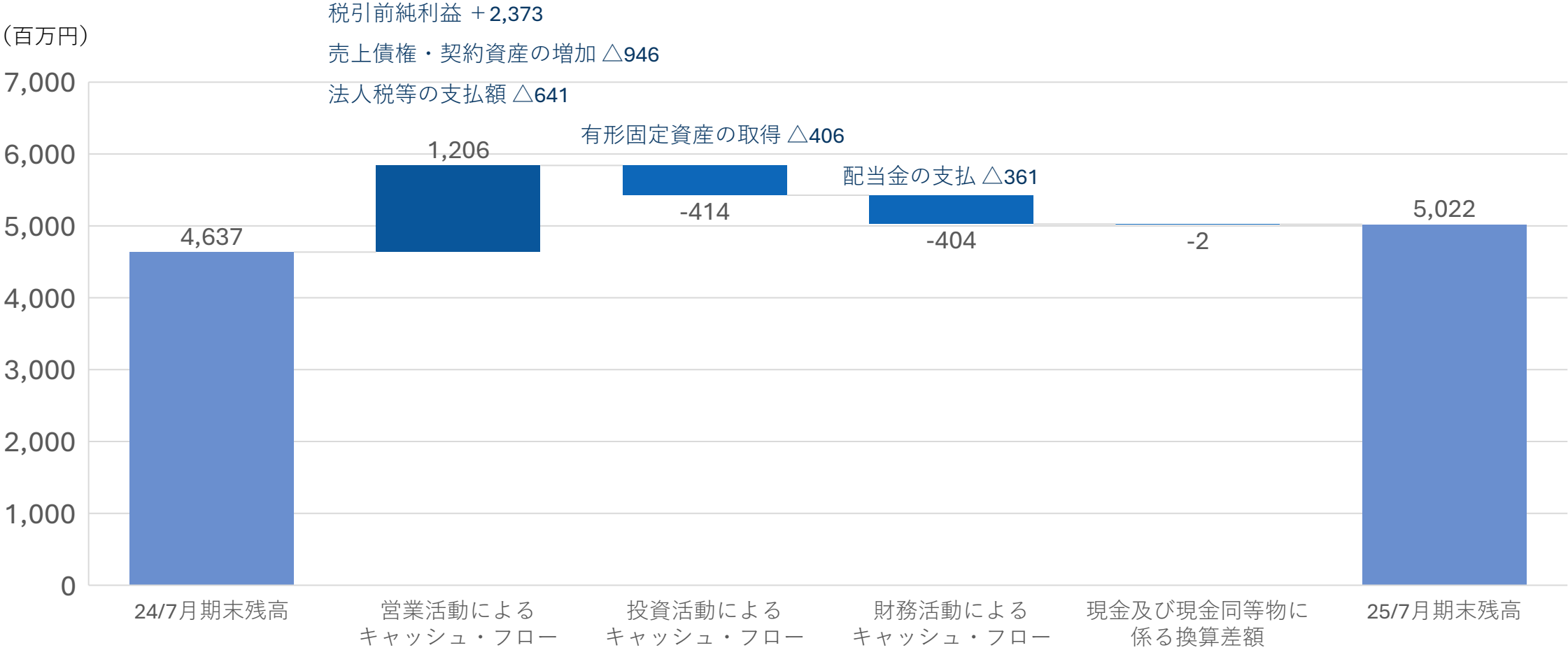


- ・ 現金及び預金 391百万円増
- ・ 受取手形・売掛金 947百万円増
- ・ たな卸資産 52百万円増
- ・ 建設仮勘定 362百万円増



- ・ 買掛金 115百万円増
- ・ 長期借入金 39百万円減
- ・ 繰越利益剰余金 1,335百万円増

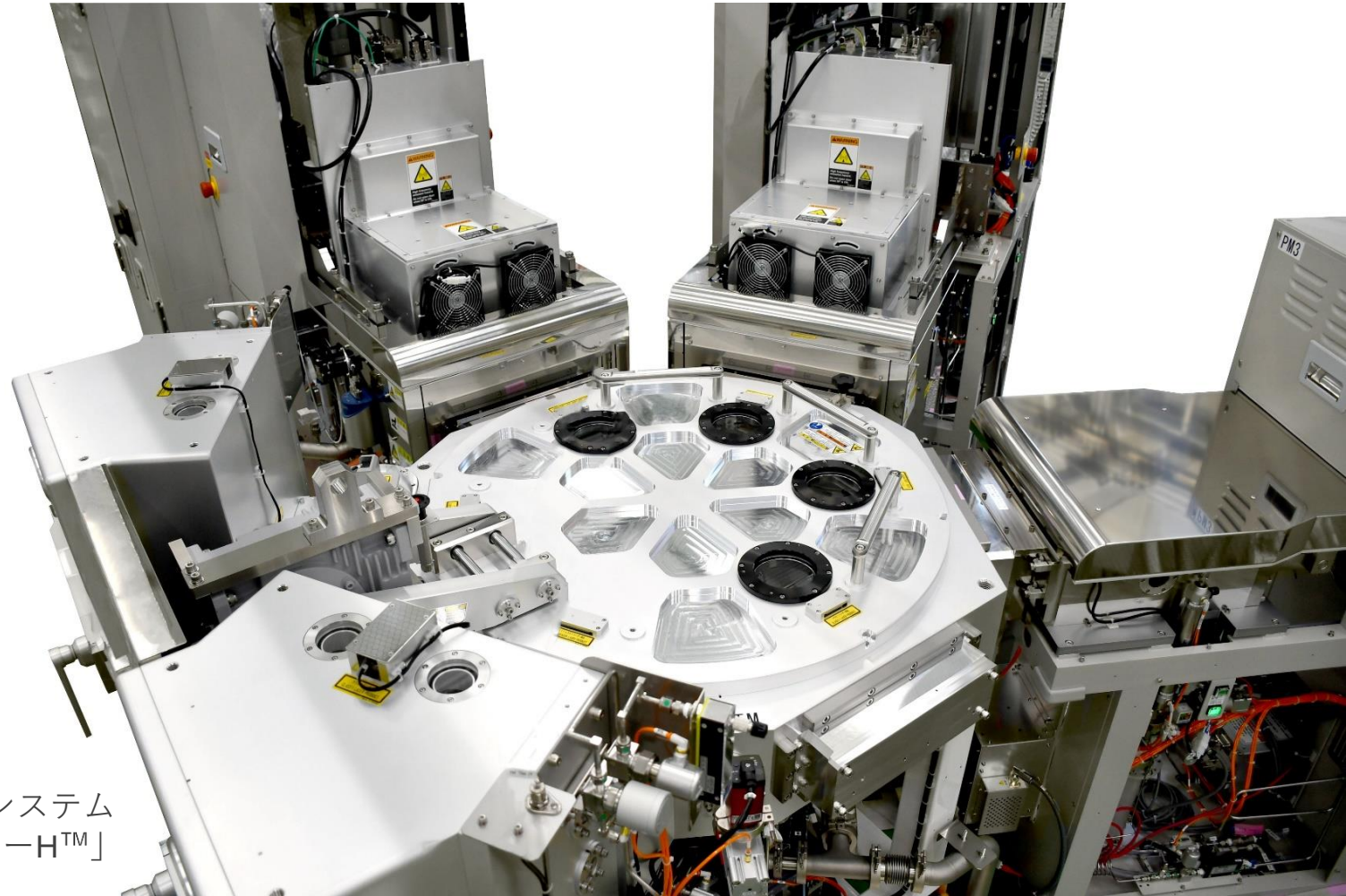
25/7月期 キャッシュ・フロー



目次

1. 2025年7月期 決算概要
2. 2026年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料

電子デバイス製造向けクラスターツールシステム
「クラスターH™」

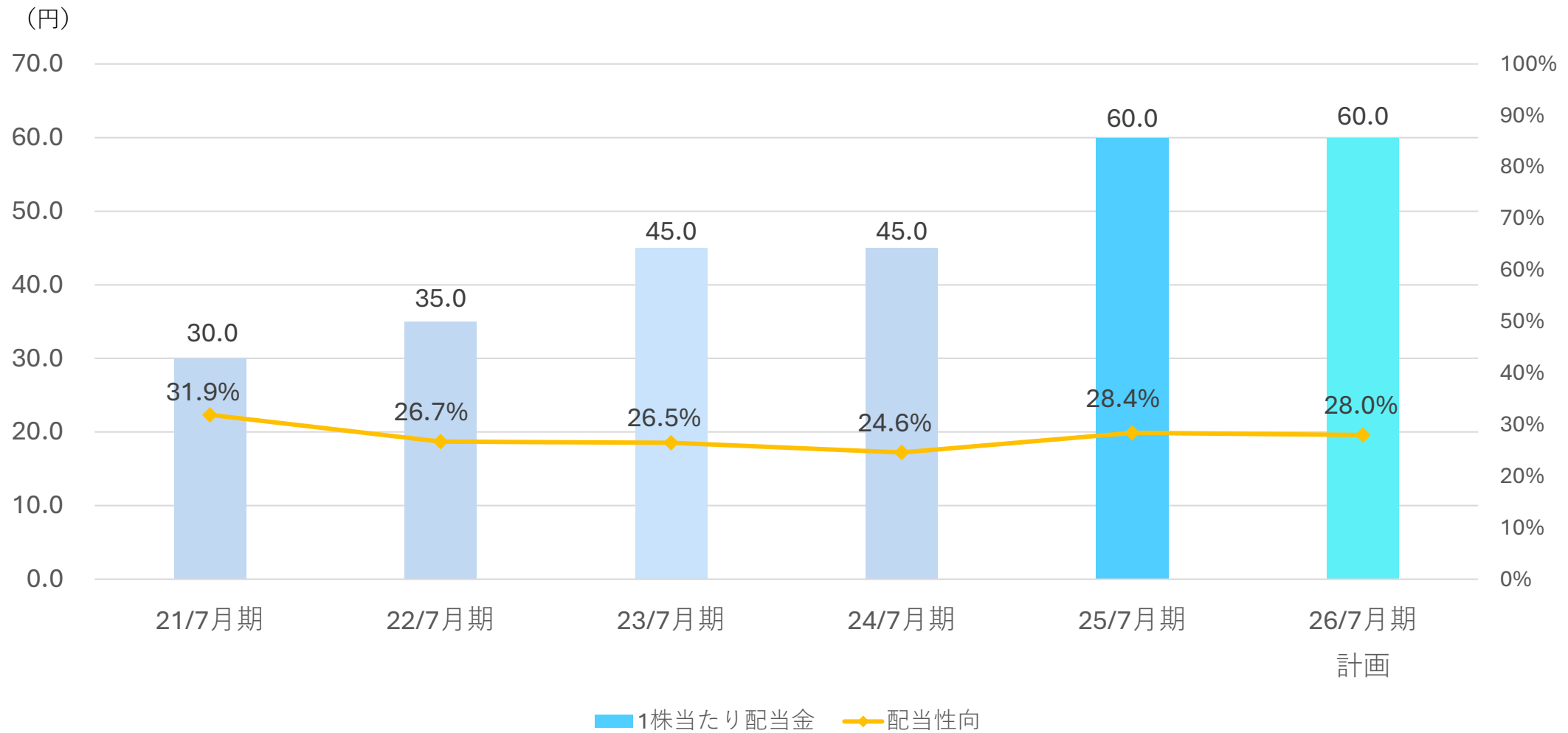


26/7月期 業績予想

(百万円)

	25/7月期	26/7月期			前年同期比
		上期予想	下期予想	通期予想	
売上高	9,342	4,750	5,450	10,200	9.2%
売上総利益	4,668	2,310	2,680	4,990	7.0%
売上高総利益率	50.0%	48.6%	49.2%	49.0%	-
営業利益	2,342	1,070	1,390	2,460	5.0%
営業利益率	25.1%	22.5%	25.5%	24.2%	-
経常利益	2,373	1,060	1,380	2,440	2.8%
当期純利益	1,697	740	980	1,720	1.4%

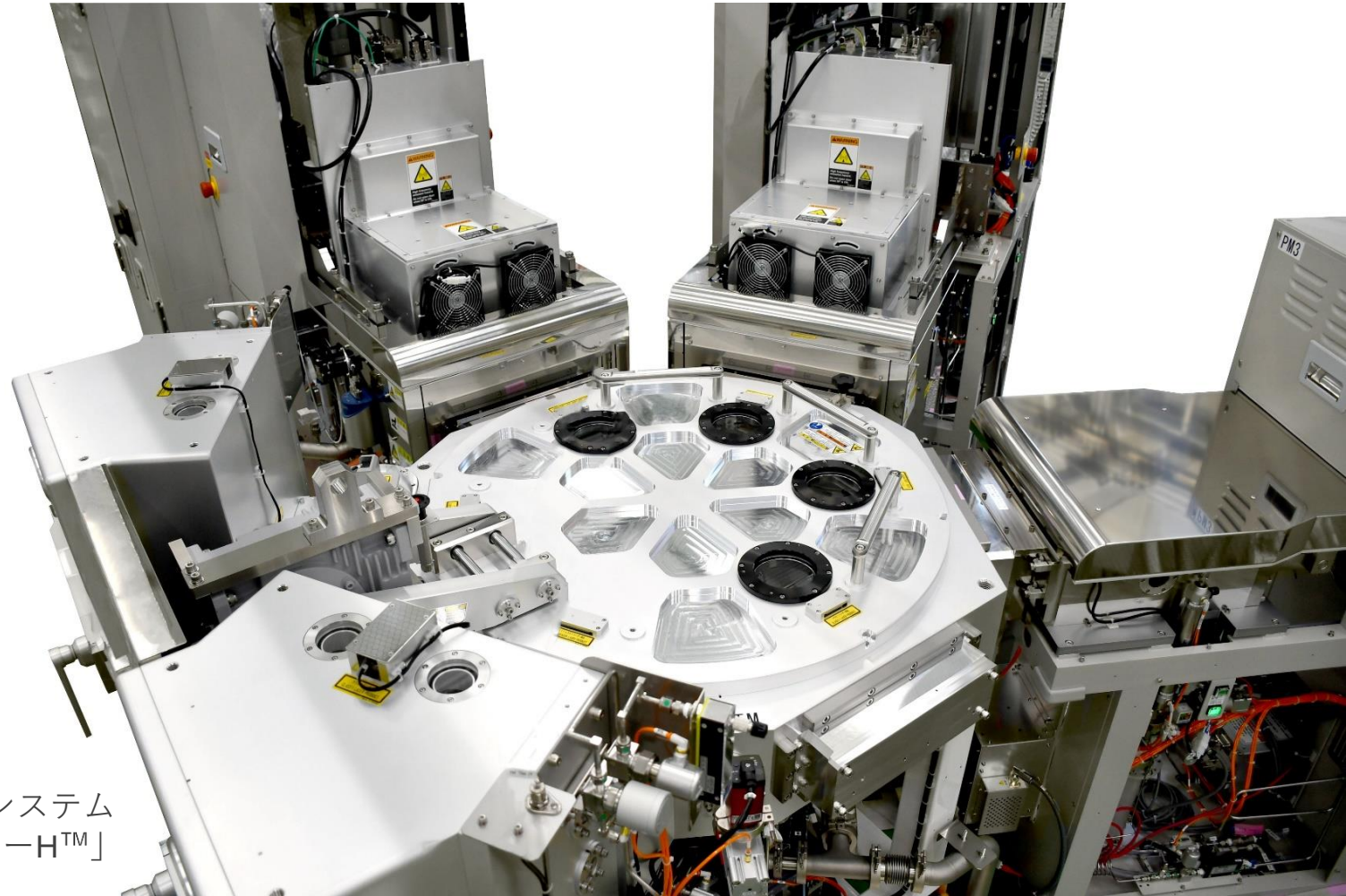
配当性向と1株当たり配当金の推移



目次

1. 2025年7月期 決算概要
2. 2026年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料

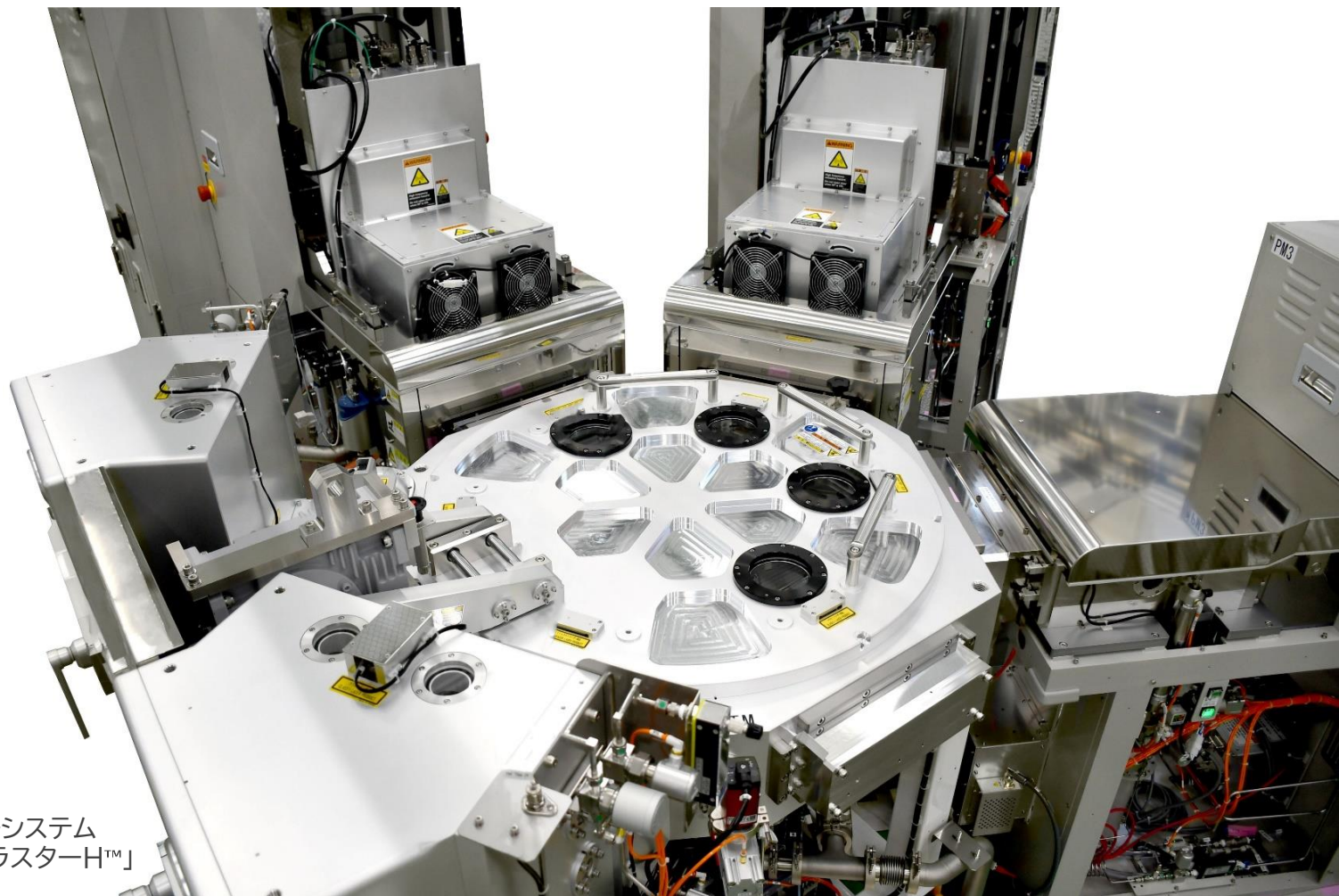
電子デバイス製造向けクラスターツールシステム
「クラスターH™」



今回納入したクラスター装置は、東北大学における材料科学、プロセス開発分野の研究力強化に貢献することを目的としています。

本装置は、薄膜形成、エッチング、プラズマ処理、熱処理など、複数のプロセスを真空中で連続して行うことが可能であり、最先端の材料開発を効果的に行うことができます。

電子デバイス製造向けクラスターツールシステム
「クラスターH™」



「先端技術開発棟」 竣工のお知らせ

2025年09月01日

設立46周年を迎えた2025年9月1日（月）に、京都市伏見区に建設していた「先端技術開発棟」を竣工しました。

先端技術開発棟のクリーンルームはクラス1,000（米国連邦規格）の清浄度で、生産工場と環境を合わせます。実験・評価装置を拡充し、成長戦略推進の要である生産機やALE（原子層エッチング）技術など新プロセスの開発を進めてまいります。



住所: 京都市伏見区竹田田中宮町93番地（現研究開発センター隣接）
建物: 地上2階建て鉄骨造, 延床面積約860平方メートル

ALE（原子層エッチング）装置を国内外の研究機関に複数台納入予定

ICPエッチング装置にALE機能をオプションとして搭載することで、従来のエッチング装置では困難であったナノメートル（ 10^{-9} メートル）レベルの微細加工制御が可能となります。

これにより、低ダメージエッチング、エッチング深さの精密制御、優れた均一性を実現いたします。

現在、国内研究機関に2台、オーストラリアの大学に1台を納入予定であり、今後は研究開発の現場での活用が期待されております。



開発部社員が米国4大学で講演を実施

2025年6月24日にUniversity of Toronto、25日にYale University、26日にCity University of New York (CUNY) およびMassachusetts Institute of Technology (MIT.nano)にて、ALE及びBoschに関する講演を実施しました。

講演では、ALE・Boschの原理や当社の処理実績、プロセス調整のポイントについて紹介し、その後に当社装置のプレゼンテーションを行いました。学生および教職員からは好意的な反応があり、質疑応答も活発に行われました。

本講演を通じて、当社のプロセス技術力を示し、将来的な装置導入に向けた認知拡大につながりました。



MITトマス・パラシオス教授、サムコ来訪

2025年3月19日（水）、マサチューセッツ工科大学（MIT）マイクロシステム技術研究所

（MTL: Microsystems Technology Laboratories）所長、
ならびに電気工学・コンピュータサイエンス分野のクラレンス・J・ルベル教授であるトマス・パラシオス博士（Dr. Tomás Palacios）がサムコを訪問され、研究開発における連携について協議しました。

当社は化合物半導体分野の最先端企業として、MITとの連携を重視しています。今回のパラシオス教授の訪問は、両者の関係をさらに深める重要な機会であり、共同研究の可能性を検討してまいります。



名古屋大学 須田先生による講演会を開催

2025年6月13日に、名古屋大学の総長補佐（GaN研究戦略室長、最先端半導体研究戦略室長）教授 須田淳先生をお招きし、「名古屋大学におけるGaN電子デバイスの研究開発」と題してご講演いただきました。

当社は、GaN電子デバイス向けにALD装置やALE装置など原子レベルの薄膜制御ができる装置をラインナップしています。

この分野を今後の成長が見込まれる重点分野として位置付け、さらに市場開拓を行ってまいります。



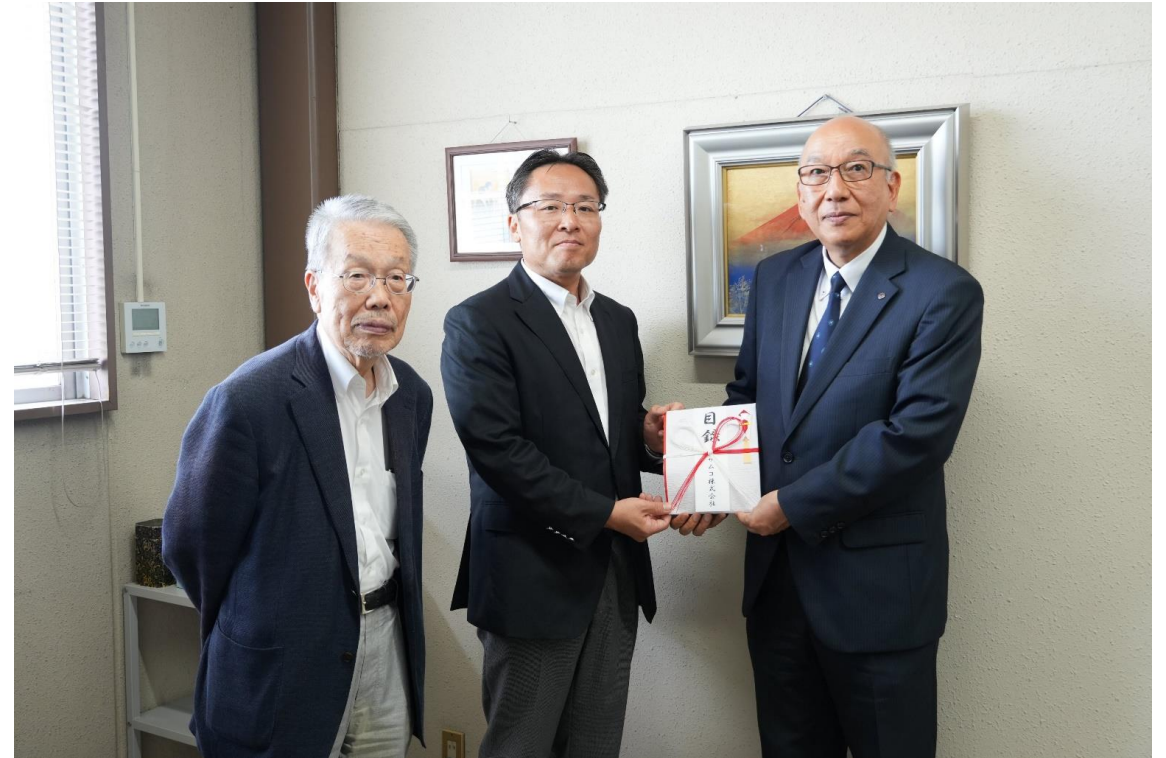
日本赤十字社への寄付について

社会貢献活動の一環として毎年決算期である7月に
日本赤十字社への寄付を行っています。

今年は、昨年に引き続き1,000万円を寄付
いたしました。

この寄付は、紛争や災害により困難な状況にある人々
への支援に尽力されている日本赤十字社の活動を支援
するものです。

日本赤十字社は、国内外での緊急援助活動、医療・福
祉事業、防災教育など、多岐にわたる人道支援を展開
しています



サムコ科学技術振興財団による活動

薄膜、表面、界面に関する研究分野の若手研究者を助成しています。財源はサムコ株式会社の株式であり、その配当金が活動資金の原資となります。

2025年9月25日、第9回研究助成金贈呈式を京都リサーチパークにて開催いたします。記念講演の講師には、ナノテクノロジーを応用したドラッグデリバリーシステム（DDS）の分野で多大な功績を挙げられた、公益財団法人川崎市産業振興財団理事長で、東京大学名誉教授の「片岡一則」先生をお招きいたします。



第8回 研究助成金贈呈式の様子（2024.9 京都リサーチパークにて）

Topics

アメリカ、インド、韓国の学生が弊社を訪問

 Cornell University



 京都大学KU-STAR



 AJOU大学



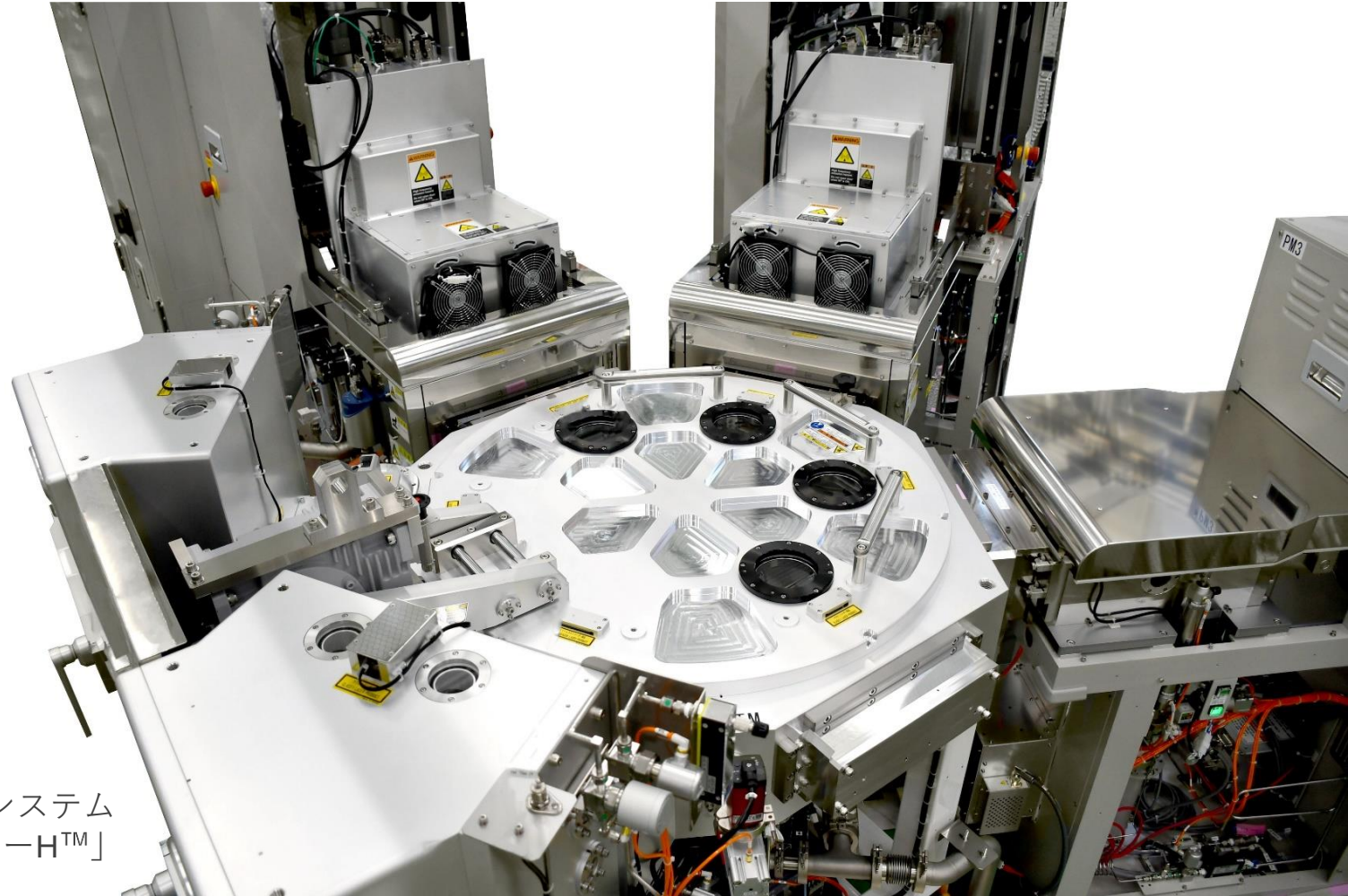
 Ohio State University



目次

1. 2025年7月期 決算概要
2. 2026年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料

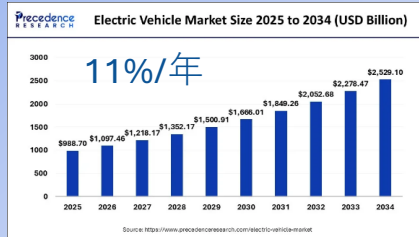
電子デバイス製造向けクラスターツールシステム
「クラスターH™」



サムコを取り巻く環境

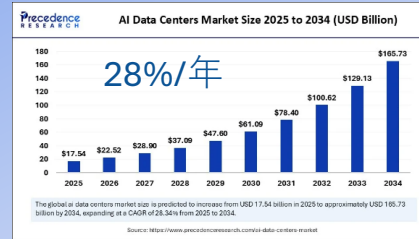
自動車の電装化と自動運転進展

- パワーエレクトロニクス
- 高精度センサー
- ECU（電子制御ユニット）



Source: Precedence RESEARCH

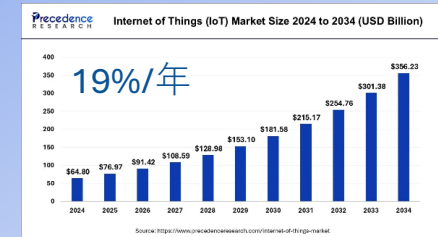
AIとデータセンターの爆発的成長



Source: Precedence RESEARCH

IoTの普及

- センサー
- 通信モジュール



Source: Precedence RESEARCH

5G/6Gと通信インフラの高度化

- 高周波部品
- 高密度実装



Source: Precedence RESEARCH

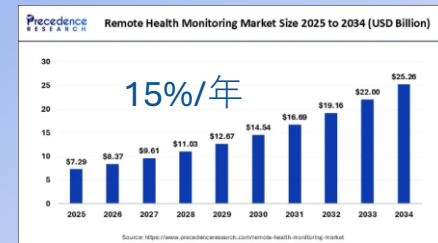
量子コンピューターの社会実装



Source: Precedence RESEARCH

ヘルスケアの拡大

- 遠隔医療
- リモートモニタリング



Source: Precedence RESEARCH

samco
PARTNERS IN PROGRESS

中期経営計画
 重要指標

装置製造原価率
46 % 以下

営業利益率
25 % 以上

海外売上比率
50 % 以上

	第46期（実績）		第49期
売上高 （前年比）	93.4億円	+32%	123億円
装置製造原価率	46.6%		46.0%
営業利益 （営業利益率）	23.4億円 （25.0%）	+34%	31.4億円 （25.6%）
海外売上高 （海外売上比率）	35.8億円 （38.4%）	+72%	61.5億円 （50.0%）
国内売上高	57.5億円	+7%	61.5億円

中期経営計画 重点施策

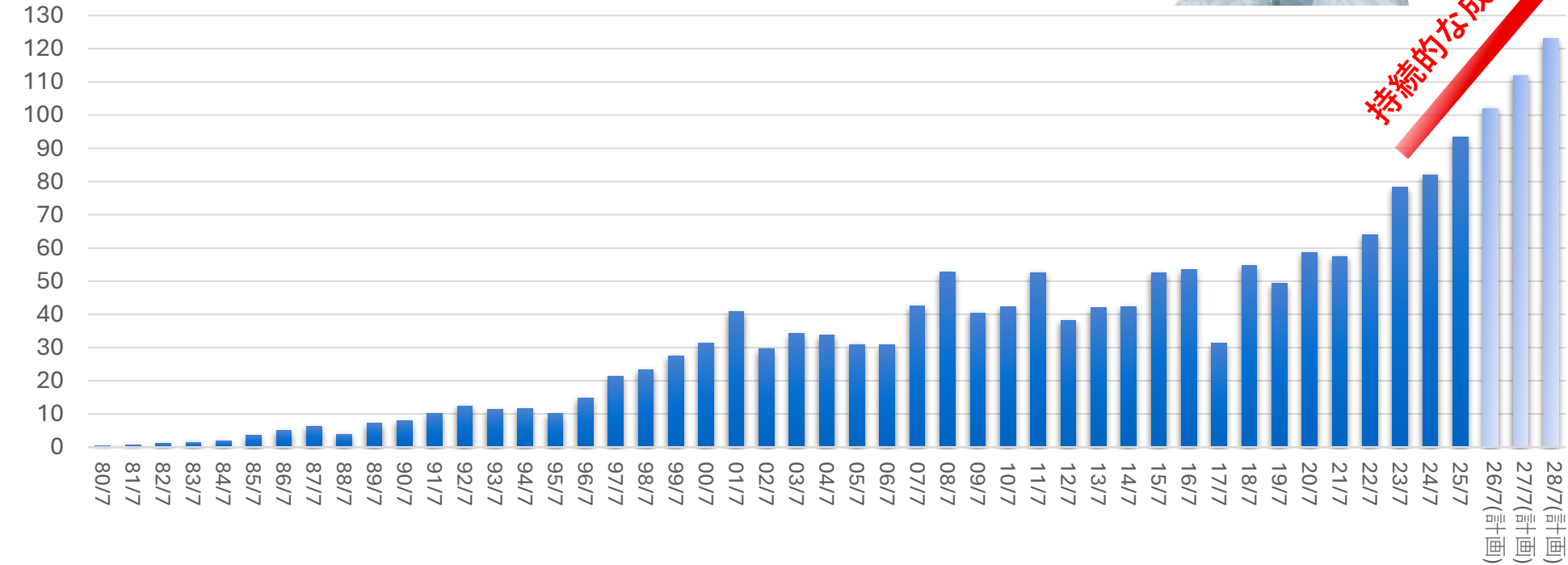
重点施策	実施項目
新しいプロセス及び新規装置の開発、販売	<ul style="list-style-type: none">・ 先端化合物半導体用途装置開発・ 電子部品用途装置開発
生産機販売の強化	<ul style="list-style-type: none">・ 専属販売チーム立上げ・ 部品、メンテナンス専属部署設立
海外販売の拡大	<ul style="list-style-type: none">・ 北米、中国、台湾、韓国、東南アジアに続くマーケット開拓・ 海外売上比率50%以上
生産体制の拡充	<ul style="list-style-type: none">・ 工場の生産能力向上・ 生産平準化
更なる成長に向けた人員育成・活躍推進	<ul style="list-style-type: none">・ 社員教育・ 高度人材の採用
サステナビリティへの取り組み	<ul style="list-style-type: none">・ 装置のCO₂排出量抑制・ 社会貢献継続

中期経営計画 — そしてその先へ、

「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」の理念のもと
右肩上がりの成長を実現



売上高
(億円)



お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail: kikaku@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



A Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology

参考資料

会社概要

商 号	サムコ株式会社 Samco Inc.
代 表 者	代表取締役会長 兼 CEO 辻 理 (つじ おさむ) 代表取締役社長 兼 COO 川邊 史 (かわべ つかさ)
設 立	1979年 (昭和54年) 9月1日
本社所在地	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36
事 業 内 容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
売 上 高	93億422万円 (2025年7月期)
従 業 員	191名 (2025年7月)
証券コード	6387 (東京証券取引所 プライム市場)



左：川邊 史、右：辻 理



最新の会社案内は[こちら](#)



当社のビジネスモデルは[こちら](#)

1980

半導体プロセス用大型CVD装置の開発、販売を開始

1981

化合物半導体製造用MOCVD装置の開発、販売を開始

国産初

1979

サムコインターナショナル研究所 設立



1984

東京都品川区に東京出張所（現東日本営業部）を開設

1987

米国カリフォルニア州にオプトフィルムス研究所を開設

沿革

液体ソースによる高速成膜用CVD装置の開発、販売を開始

1990

1995

小型、汎用プラズマエッチング装置RIE-10NR
の開発、販売を開始

700 台
以上の実績



1997

キンビール株式会社と共同で、
プラスチックボトルにDLC膜を形成する技術を開発

2001

日本証券業協会に株式を店頭上場

2004

株式会社サムコインターナショナル研究所から
サムコ 株式会社へ社名を変更

沿革

2015

原子層堆積（ALD）装置AL-1の開発・販売を開始

2016

Aqua Plasma®洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始

2021

クラスターツールシステム「クラスターH™」の販売を開始

2013

東京証券取引所市場第二部へ上場市場を変更

2014

東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2022

プライム市場へ移行

2025

先端技術研究棟を竣工

先端
技術研究棟
竣工



国内営業拠点



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟



つくば営業所

東日本営業部

東海支店

▶ [事業拠点 | サムコ株式会社 \(samco.co.jp\)](https://samco.co.jp)

本社周辺のアクセスマップやGoogle mapのご案内はこちら

海外営業・サービス拠点（11拠点）



▶ 事業拠点 | サムコ株式会社 (samco.co.jp)

海外拠点の住所やGoogle mapのご案内はこちら

経営理念、経営方針

Mission

経営理念

- 企業の永続的な発展を追求し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者とともに成長する企業を目指して、

薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。

経営方針

1. 社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。
2. 直販体制を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。
3. 事業が社会に果たす役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

Vision

サムコの目指すグローバル中堅企業

1. 世界中で自由にビジネスを展開し、自社の独自技術を活かし、質の高い製品とサービスを提供し続ける。
2. コア技術（薄膜技術）をベースに、参入障壁の高い領域において、特定の製品で圧倒的シェアを有することで、自ら製品に値付けが出来る力を持ち、高い収益率を維持し続ける。
3. 売上の規模を求めるだけでなく、継続的に利益を稼げる市場に特化、集中する。
4. 組織体制は少数精鋭のプロ集団である。
5. 適正な税金を納め、国家や地域の発展にも貢献する。

製品ラインナップ



deposition

■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



etching

■ドライエッチング装置

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置



surface
treatment

■ドライ洗浄装置

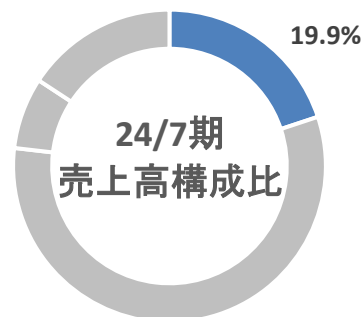
- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー





装置ラインナップ

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



概要

反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS (Liquid Source) - CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能です。

2015年12月から販売を開始した原子層堆積装置 (ALD = Atomic Layer Deposition) はCVD装置に分類しております。ALD装置は、反応室に有機金属原料と酸化剤を交互に供給し、表面反応のみを利用して成膜を行う装置であり、高い膜厚制御性と良好な段差被覆性を実現することが可能です。

第45期有価証券報告書 (2024.10.22提出) より



CVD装置の詳細は [こちら](#)

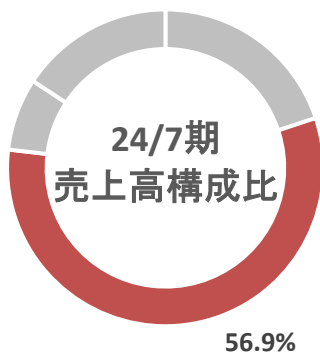


CVD装置とは ⇒ [こちら](#)
(半導体製造装置入門より)



装置ラインナップ

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- XeF2ドライエッチング装置



エッチング装置の詳細は[こちら](#)



エッチング装置とは⇒[こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

概要

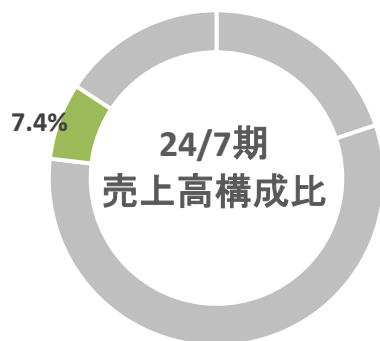
各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP（Inductively Coupled Plasma＝高密度プラズマ）を利用するエッチング装置では、高密度プラズマを安定して生成し、高速で高精度の微細加工が可能です。

第45期有価証券報告書（2024.10.22提出）より



装置ラインナップ

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー



概要

実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウェット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能です。

2016年9月より販売を開始した水蒸気（H₂O）を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma（アクアプラズマ）洗浄装置は、金属酸化膜の還元、有機汚れの洗浄、樹脂接合、超親水化などの表面処理を、安全で環境に優しく行うことが可能です。

第45期有価証券報告書（2024.10.22提出）より



洗浄装置の詳細は [こちら](#)



洗浄装置とは⇒[こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 部品・メンテナンス

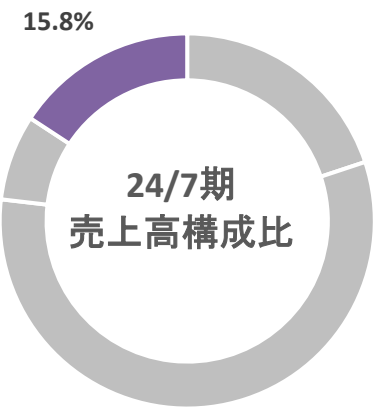
主な内訳

- ・ 部品、消耗品
- ・ 修理、改造
- ・ 移設、作業
- ・ メンテナンス

概 要

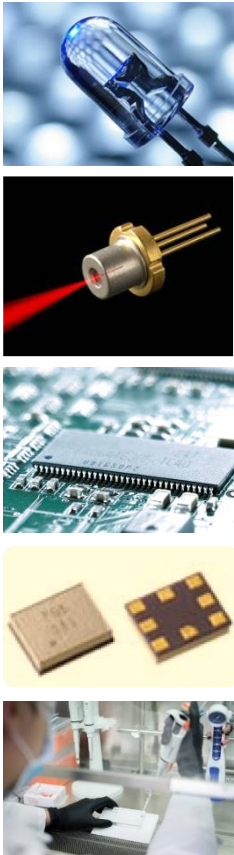
当社装置の納品後のアフターサービスに係る売上を、部品・メンテナンスの売上高として計上しております。交換用の部品や消耗品をはじめ、装置の修理や改造、また装置の移設やそれに伴う作業費、メンテナンス費用等があります。

第45期有価証券報告書（2024.10.22提出）より



用途別売上高区分

用 途	概 要
化合物半導体分野	GaN（窒化ガリウム）、GaAs（ガリウムヒ素）、InP（インジウムリン）、SiC（炭化シリコン）などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途です。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT（High Electron Mobility Transistor）などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハーの欠陥解析及びシリコン半導体、シリコンフォトリソに関する加工用途です。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途です。主にMEMS（Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム）、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途などです。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途です。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。第45期有価証券報告書（2024.10.22提出）より



事業領域 化合物半導体の例

化合物半導体は、複数の異なる元素を組み合わせることで、シリコンのような単元素の半導体では実現できない特性を得ることができます。

高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っており、スマートフォンの高周波デバイスやLD、LED、次世代パワーデバイスなどの材料として利用されています。

デバイスの例	材料の例	最終製品・用途の例
LD（半導体レーザー）	GaAs、InGaAsP、InP	スマートフォン顔認証システム、自動車の自動運転システム、無線基地局・衛星、光通信
LED、マイクロLED	GaN、AlInGaP、GaP	液晶ディスプレイ、照明、自動車ヘッドライト
パワーデバイス	SiC、GaN、Ga ₂ O ₃	鉄道車両インバーター、電気自動車の充電ユニット、データセンター、ノートパソコン等の急速充電器

地域別売上高区分

当社では、当社の製品が使用される地域（国）によって、売上高を以下の地域に区分しております。

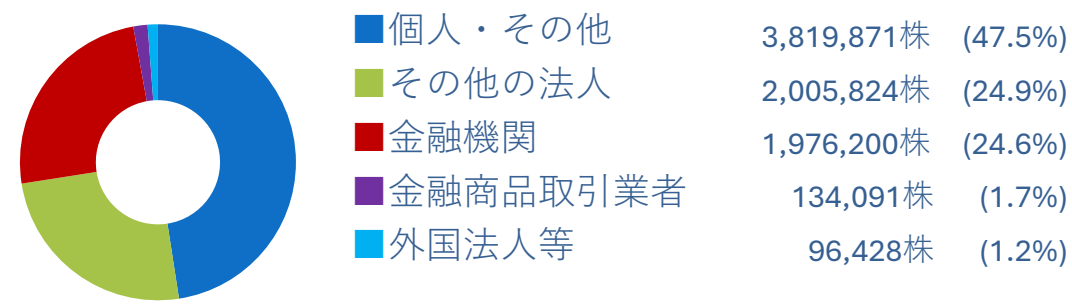
地 域		対象となる国
日 本	日本国内	
アジア	台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド 他	
北 米	米国、カナダ、メキシコ	
欧 州	ブルガリア、ドイツ、イギリス、フィンランド、ポルトガル、スペイン、イタリア、トルコ、スウェーデン 他	
その他	オーストラリア、エジプト 他	

当社 第45期有価証券報告書（2024.10.22提出）より

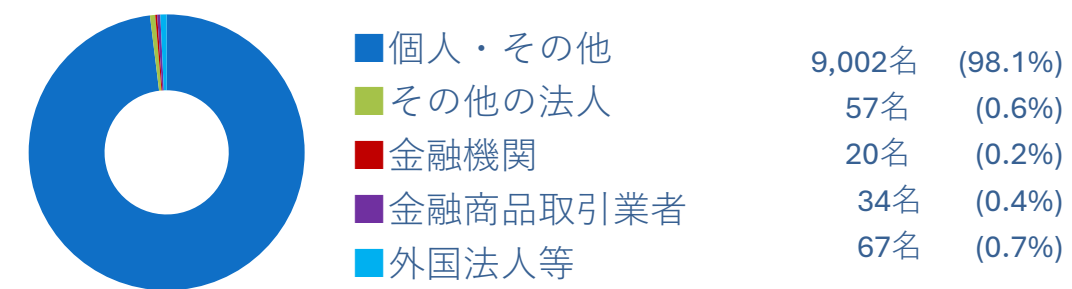
株式の状況（2025年7月末時点）

- ・ 発行可能株式総数 14,400,000株
- ・ 発行済株式の総数 8,042,881株
- ・ 株主数 9,181名

所有者別株式分布状況（株式数ベース）



所有者別株式分布状況（株主数ベース）



株主名	持株数（株）	持株比率（%）
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	920,300	11.5
辻 理	863,907	10.8
サムコエンジニアリング株式会社	850,282	10.6
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	238,900	3.0
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社（投信口）	153,300	1.9
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
立田 利明	103,099	1.3
三菱UFJキャピタル株式会社	102,931	1.3

主要数値の変遷

	21/7月期	22/7月期	23/7月期	24/7月期	25/7月
売上高（百万円）	5,746	6,401	7,830	8,203	9,342
営業利益（百万円）	989	1,371	1,858	2,017	2,342
営業利益率（%）	17.2	21.4	23.7	24.6	25.1
経常利益（百万円）	1,044	1,481	1,927	2,088	2,373
当期純利益（百万円）	755	1,052	1,366	1,471	1,697
総資産（百万円）	12,069	13,379	14,795	16,116	18,205
自己資本（百万円）	9,410	10,057	11,144	12,299	13,852
自己資本比率（%）	78.0	75.2	75.3	76.3	76.1
ROE（%）	8.3	10.8	12.9	12.6	13.0
減価償却費（百万円）	95	76	57	83	81
設備投資額（百万円）	737	234	33	276	456
研究開発費（百万円）	264	255	242	262	302
EPS（円）	94.09	131.07	170.07	183.25	211.27
配当金（円）	30	35	45	45	60

ESG・サステナビリティ



持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～	
<div>E 環境</div>	<p>＜＜気候変動・脱炭素への取り組み＞＞</p> <ul style="list-style-type: none">・TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。・環境方針（2006年制定）に沿った取り組みを実施。 <p>＜＜環境配慮型製品＞＞</p> <ul style="list-style-type: none">・省エネ・脱炭素を支えるLED、レーザー、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。・コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。・主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減
<div>S 社会</div>	<p>＜＜事業を通じた社会的価値の創造＞＞</p> <ul style="list-style-type: none">・顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造 <p>＜＜社会貢献、地域貢献＞＞</p> <ul style="list-style-type: none">・サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動 ・京都工繊繊維大学への寄附講座、東高瀬川ビジネスコミュニティへの参画・従業員、会社からの寄付金活動。（日本赤十字社、京都大学ほか） ・献血活動に協力
<div>G ガバナンス</div>	<p>＜＜ガバナンス体制、ダイバーシティ＞＞</p> <ul style="list-style-type: none">・役員12名中、社外役員6名（うち女性1名）・取締役会の実効性評価による改善、検討。・多様な人材確保。（女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍）

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社が重点的に取り組むSDGs



上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概 要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。



気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。

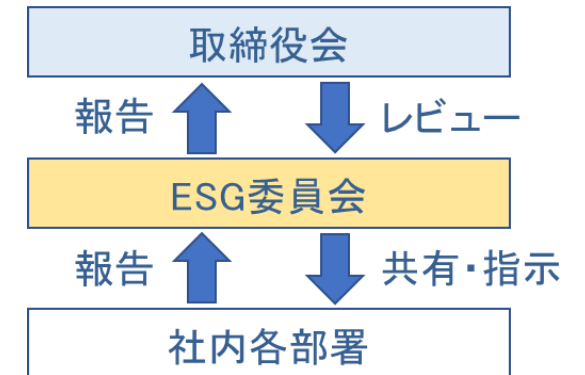
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。

ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。

⇒活動内容を取締役会に年1回以上報告

⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・

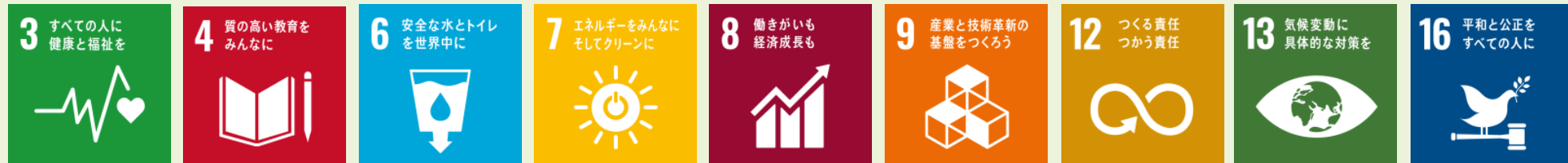
ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

サムコとSDGsの関わり






- ・ 当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・ SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追究し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。

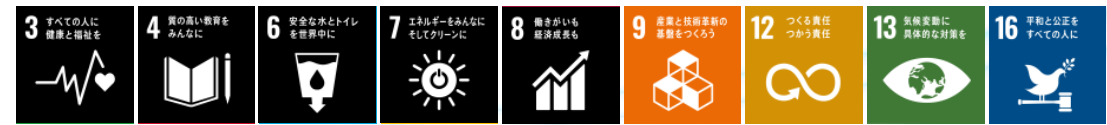






サムコのSDGsの取り組み例



 <p>3 すべての人に健康と福祉を</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アクアプラズマ技術の寄与を目指す。 ・ 深紫外LED空気清浄機（コロナウィルス不活性化）製造に当社装置が寄与。 ・ 医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。 ・ 日本赤十字社への寄付。（ウクライナ人道危機救援金、能登半島地震災害義援金、トンガ大津波支援等）
 <p>4 質の高い教育をみんなに</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国内外の大学（ODA案件を含む）・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。 ・ サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる若手研究者を支援。 ・ 京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。
 <p>6 安全な水とトイレを世界中に</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。 ・ 深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。
 <p>7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC（炭化シリコン）、GaN（窒化ガリウム）、酸化ガリウム（Ga₂O₃）等の加工に当社装置が寄与。 ・ 高効率LED素子、マイクロLEDや、LD（レーザー）の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。
 <p>8 働きがいも経済成長も</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当社はファブライツ企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。 ・ 勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。 ・ 役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。 ・ 多様な人材確保。 （女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍）

サムコのSDGsの取り組み例



	<p>産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL（面発光レーザー）を含む通信用LD（レーザー）用装置の製造。 ・自動運転用のセンシング技術（LiDAR）、各種センサーや宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。 ・有機EL、マイクロLEDの製造。 ・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。
	<ul style="list-style-type: none"> ・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。 ・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。 <p>主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。 ・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
	<ul style="list-style-type: none"> ・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。 ・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。

サムコの人材育成方針



1. 仕事は楽しく、面白くあるべきである。一所懸命に楽しく仕事をして、かつ面白い。そして良い結果がついてくる。
そんな楽しく、面白い日々が日常である会社とする。
2. “学ぶ”を忘れない。学ぶことを常に念頭に置き、長きに渡り己を磨くことで自らの価値を高めてほしい。
特に若手社員は30代までに能力向上に勤しむ癖をつけないといけない。
3. リスキリングにより第一線で活躍できるスキルを身に付けることにより、70歳まで働ける企業としていく。シニア社員が十分社会貢献できるよう再教育することを会社の使命と考える。
4. 外国籍社員の採用を増やし、若手社員の海外経験を増やすことによりグローバル人材の育成を図る。
5. 階層別の教育訓練制度（部長塾、課長塾、成長塾）を発展的に継続し、多角的な視野で経営管理できる人材の育成を図る。
6. たえず組織の新陳代謝を図り、新たな細胞（多様な人材）を積極的に登用していく。
人事異動は社員の層を厚くし、組織を重層化する目的もあり、新たな能力の開拓につなげる。
女性社員も大きな戦力として、管理職で活躍をしてもらえるように環境を整備する。

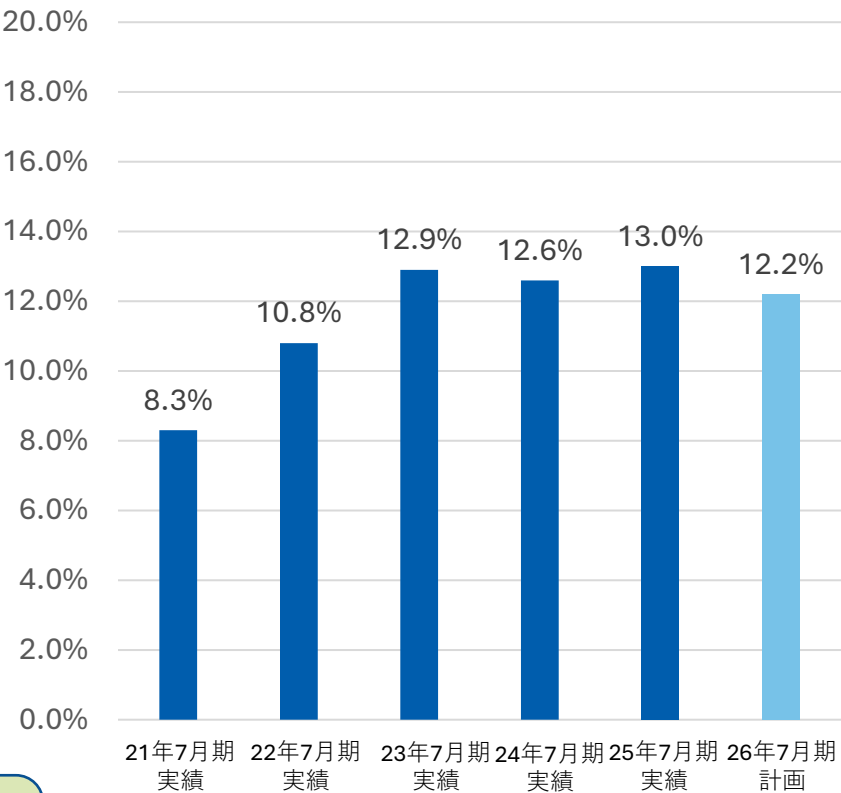


資本コストや原価を意識した経営の実現に向けた対応

当社は、中長期的な経営指標として「装置製造原価率46%以下」「売上高営業利益率25%以上」「海外売上高比率50%以上」を掲げ、収益性と成長性を重視した経営の実現に向け対応しております。

当社の2024年7月期（第45期）のROEは12.6%であり、第46期は13.0%となりました。2026年7月期（第47期）の計画は12.2%です。また、「資本コスト」については、その概念や計算方法について統一的な基準が示されておらず、一般的な指標になっていないことより、当社の経営指標や開示情報には用いておりませんが、新規事業等への新たな投資については現状のROE水準を意識した経営を実践しております。

なお、当社の2025年7月31日時点のPBRは1.66倍となっており、株価についても意識した経営を継続いたします。



ROE
(Return On Equity)
自己資本当期純利益率

×

PER
(Price Earnings Ratio)
株価収益率

=

PBR
(Price Book-value Ratio)
株価純資産倍率

コーポレートガバナンス報告書は[こちら](#)

株主・投資家との対話状況

基本方針

当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話を行うこととしております。株主との対話につきましては、代表取締役社長 川邊 史の管掌の下、専任部署である経営企画室（2025年7月現在3名）を中心に、経理部、総務部、社長室などの関連部署と密接に連携しつつ、IR活動を行っています。また、対話に際しては内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

対話を行った株主の概要 対象期間：2024年8月1日から2025年7月31日までの1年間

【機関投資家・アナリスト向け】

- ・ 1 on 1 ミーティング 103件
- ・ 機関投資家・アナリスト向け オンライン決算説明会 年2回（Zoomウェビナー形式／中間期3月、期末9月）

【個人投資家向け】

- ・ 株主総会後の会社説明会 年1回（10月）
- ・ 第45期 年次報告書（2024年10月）にて株主アンケートを実施し、その結果を第46期 中間期報告書（2025年4月）にて公表。
- ・ 個人投資家からの電話・メール問い合わせ対応 随時

投資家の皆様との建設的な対話を通じ、企業価値向上に繋げてまいりたいと考えております。

その他、対話の実例、取締役会に対するフィードバック、取り入れた事項などはHPに掲載 ⇒

株主・投資家との対話状況の詳細は[こちら](#)

IRカレンダー



お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail: kikaku@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



A Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology